



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

**HX3904**

对应国外型号  
2N3904

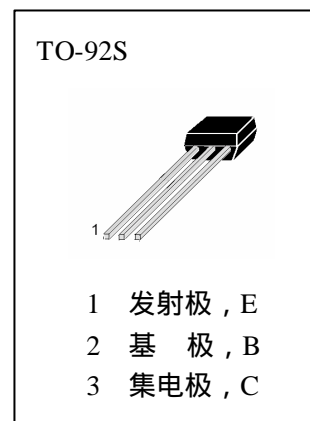
### 主要用途

小信号放大、高频振荡、开关应用。

### 极限值 ( $T_a=25$ )

$T_{stg}$ ——贮存温度.....	-55~150
$T_j$ ——结温.....	150
$P_C$ ——集电极耗散功率.....	300mW
$V_{CBO}$ ——集电极—基极电压.....	60V
$V_{CEO}$ ——集电极—发射极电压.....	40V
$V_{EBO}$ ——发射极—基极电压.....	5V
$I_C$ ——集电极电流.....	200mA

### 外形图及引脚排列



### 电参数 ( $T_a=25$ )

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
$I_{CBO}$	集电极—基极截止电流			0.1	$\mu A$	$V_{CB}=60V, I_E=0$
$I_{EBO}$	发射极—基极截止电流			0.1	$\mu A$	$V_{EB}=5V, I_C=0$
HFE	直流电流增益	70		350		$V_{CE}=1V, I_C=10mA$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压			0.2	V	$I_C=10mA, I_B=1mA$
$V_{BE(sat)}$	基极—发射极饱和电压			0.85	V	$I_C=10mA, I_B=1mA$
$BV_{CBO}$	集电极—基极击穿电压	60			V	$I_C=100\mu A, I_E=0$
$BV_{CEO}$	集电极—发射极击穿电压	40			V	$I_C=10mA, I_B=0$
$BV_{EBO}$	发射极—基极击穿电压	5			V	$I_E=10\mu A, I_C=0$
$f_T$	特征频率	300			MHz	$V_{CE}=20V, I_C=10mA$ $f=100MHz$

### 分档及其标志

A	B
70—240	220—350